

The Data Book Project

DatasheetArchive.com has launched an ambitious effort to digitize thousands of obsolete data books and technical manuals, making them searchable via the DatasheetArchive website.

Scroll down to see the scanned document.

FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS :

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_c=25^\circ\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_c=25^\circ\text{C}$)										外 形	備 考
				V_{ce0} (V)	V_{be0} (V)	I_c (mA)	P_c (mW)	T_c ($^\circ\text{C}$)	I_{c0} 最大値 (μA)	直流又はパルス h_{FE}		バイアス		h_{FE}	h_{ie} h_{ie}^* (Ω)	h_{re} h_{re}^* ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{oe}^* (μS)	$f_{\alpha b}$ $f_{\alpha b}^*$ (Mc)		
1	2	3	4	5					6		7		8				9	10	11	12

- 1 TYPE NUMBER
- 2 ORIGINAL MANUFACTURER
- 3 USES
- 4 MATERIAL AND STRUCTURE
- 5 MAXIMUM RATINGS
- 6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})
- 7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})
- 8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

- * INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.
- 9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T .
- 10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)
- 11 OUTLINE
- 12 REMARKS

:とコンプリ: COMPLEMENTARY TO

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta = 25°C)					電 気 的 特 性 (Ta = 25°C)													外 形	備 考				
				VcBo (V)	VEBo (V)	Ic (mA)	Pc (mW)	Tj (°C)	ICBo最大値		直流又はパルス		hFE		バイアス		hfe hfs*	hfc hfs* (Ω)	hrr hrr* (×10 ⁻⁴)	h _{re} h _{re} * (μU)	f _{os} f _{os} * (Mc)			C _{ob} (pF)	f _{3dB} h _{ic} (real)* (Ω)		
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{fs} *	h _{fs} *											
2SC1871	日立	SW	Si.E.Me	450	7	10A	100W (Tc=25°C)	150	100	400	>15	5	5A											102			
" 1872																											
" 1873																											
" 1874																											
" 1875	日電	SW	Si.TMe	1500	6	3.5A	50W (Tc=25°C)	150	20	1000	19	10	500										102				
" 1876	日立	RF.SW	Si.E	100	7	500	800	175	100	100	>2000	10	100										84B	テーリント			
" 1877																											
" 1878																											
" 1879	日立	RF.SW	Si.E	120	7	2A	800	175	100	120	>1000	2	2A										84B	テーリントン 薄型構造 が異なる			
" 1880	"	"	"	120	7	2A	15W (Tc=25°C)	150	0.1	100	4000	2	2A										268	テーリントン			
" 1881	"	"	"	60	7	3A	30W (Tc=25°C)	150	200	60	>1000	1.5	1.5A										268	テーリントン			
" 1882	"	"	"	120	12	5A	800	175	1	100	5000	5	5A	10	-100	t _{on} < 0.6μS, t _{off} < 3μS t _{sig} < 2μS				46 *	29	15	85B	テーリントン 薄型構造 が異なる			
" 1883	"	"	"	120	7	5A	30W (Tc=25°C)	150	1	100	4000	2	5A	10	-1A	t _{on} < 2μS, t _{off} < 16μS t _{sig} < 10μS				10 *	80	10	268	テーリントン			
" 1884	"	"	"	120	7	8A	40W (Tc=25°C)	150	1	100	>1000	2	8A											153	テーリントン		
" 1885	松下	RF	Si.EP	150	5	50	750	135	1	100	150	5	10	10	-10							200 *	2	3.5k *	165		
" 1886	日立	RF.Mix.Osc	"	30	2	50	200	125	0.5	10	80	10	10	10	-10							1000 *	1.2	C _c τ _{db} 10pS	138		
" 1887	"	RF.Osc	"	30	2	50	200	125	0.5	10	80	10	10	10	-10							1100 *	1.2	C _c τ _{db} 10pS	138		
" 1888	サンケン	PA	Si.TMe	80	6	3A	800	150	100	80	1000	5	100	5	-100							15 *	35	250 *	84B		
" 1889	"	"	"	100	6	3A	800	150	100	100	1000	5	100	5	-100							15 *	35	250 *	84B		
" 1890	日立	AF	Si.E	90	5	50	300	125	0.5	75	250~1200	12	2	12	-2							200 *	1.6		138	2SA893 とコブアリ	
★ " 1891	東芝	PA	Si.TMe	1200	5	1.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	10	500	10	-100							t _f < 1μS	3 *	45		102	水平偏向用
★ " 1892	"	"	"	1500	5	2.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	10	1A	10	-100							t _f < 1μS	3 *	95		102	水平偏向用
★ " 1893	"	"	"	1500	5	3.5A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	10	1A	10	-100							t _f < 1μS	3 *	95		102	水平偏向用
★ " 1894	"	"	"	1500	5	5A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	10	2A	10	-100							t _f < 1μS	3 *	155		102	水平偏向用
★ " 1895	"	"	"	1500	5	6A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	10	2A	10	-100							t _f < 1μS	2 *	165		102	水平偏向用
★ " 1896	"	"	"	1500	5	7A	50W (Tc=25°C)	150	10	500	20	10	2A	10	-100							t _f < 1μS	2 *	165		102	水平偏向用
" 1897	新日無	RF	Si.EP	30	6	1A	600	125	0.5	20	200	1	100	10	-50							200 *	20	C _c τ _{db} 100pS	138		
" 1898	"	"	"	30	4	30	200	125	0.5	20	90	6	1	10	-2							500 *	0.9	C _c τ _{db} 8pS	138C		
" 1899	"	"	Si.P	30	4	20	200	125	0.5	20	90	6	1	10	-2							500 *	0.9	C _c τ _{db} 8pS	138C		
" 1900	"	RF.LN	"	120	6	50	300	125	0.05	20	300	6	1	6	-0.1			50k	5	15	90 *	2	C _c τ _{db} 50pS	138			